

D120LC40B

400V 120A

特長

- 大電流容量
- trr=100ns
- 絶縁型

Feature

- High I_o Rating
- trr=100ns
- Isolation type

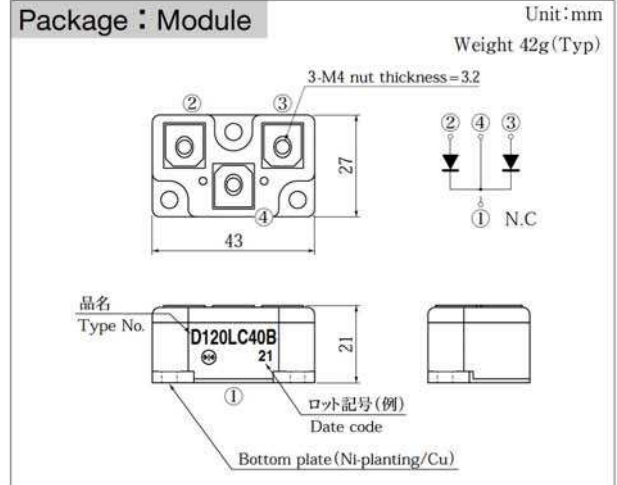
用途

- 半導体製造装置
- 大型電源
- FA

Main Use

- Semiconductor Process Machine
- High power source
- Factory Automation

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

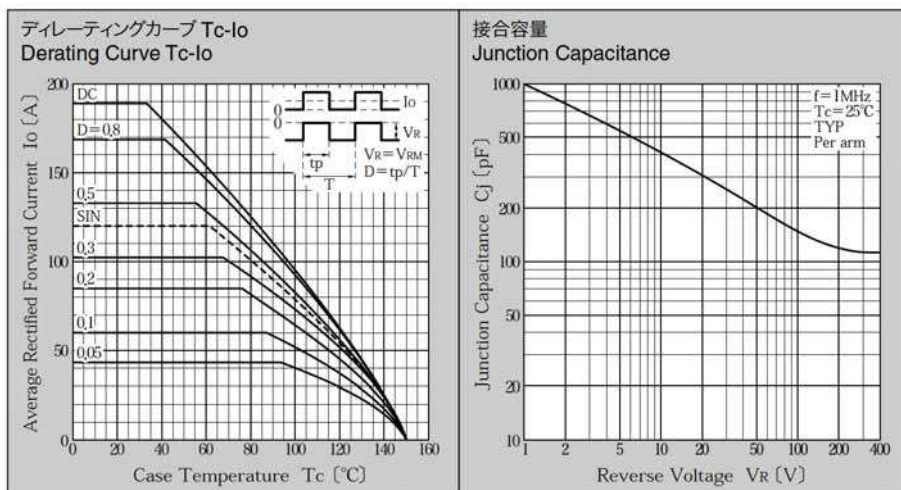
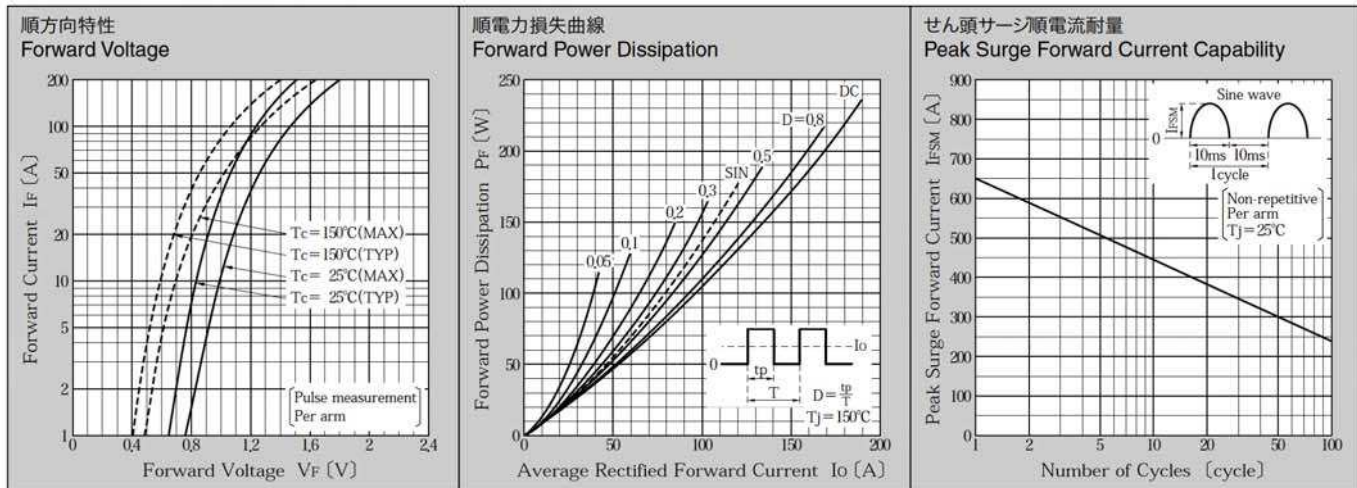
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 T_c = 25℃)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D120LC40B	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}			-40~150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			400	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _o	50Hz正弦波, 抵抗負荷, フィン付き, 1素子当りの出力電流平均値 I _o /2, T _c = 60℃ 50Hz sine wave, Resistance load, With heatsink, Per diode I _o /2, T _c = 60℃		120	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, 1素子当りの規格値, T _j = 25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Per diode, T _j = 25℃		650	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース間, AC1分間印加 Terminals to case, AC 1 minute		1.5	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR			1.7	N·m

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 T_c = 25℃)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 60 A,	パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 1.30	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} ,	パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 25	μA
回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I _F = 0.5 A, I _R = 1.0 A,	1素子当りの規格値 Per diode	MAX 100	ns
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case		MAX 0.5	℃/W

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 * Typicalは統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 * Typical is a statistical average of the device's ability.